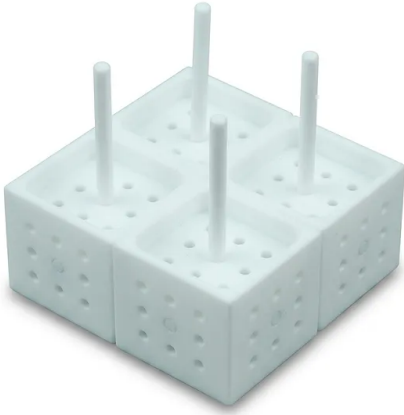


반도체 식각 및 신에너지 공정용 맞춤형 PTFE 웨이퍼 세척 플라워 바스켓 내화학성 플루오로폴리머 캐리어

품목 번호: PL-CP149



소개

맞춤형 PTFE 웨이퍼 세척 플라워 바스켓으로 반도체 및 신에너지 제조 공정을 최적화하세요. 식각 및 RCA 세척 중 극한의 내화학성을 위해 설계된 이 고순도 플루오로폴리머 캐리어는 까다로운 산업 환경에서 공정 무결성과 장기 내구성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 RCA 세척	SC-1 및 SC-2 용액을 사용하여 유기 및 금속 오염물질을 제거하는 실리콘 웨이퍼의 순차적 세척.	제로 오염 및 암모니아/과산화수소 혼합물에 대한 저항성.
불산(HF) 식각	웨이퍼 표면의 자연 산화막 제거 또는 이산화규소 층의 제어 식각.	유리 또는 석영 대안을 용해시킬 불산에 대한 절대적 저항성.
태양광 텍스처링	광 트래핑 표면을 생성하기 위한 단결정 또는 다결정 실리콘 웨이퍼의 습식 화학 식각.	일관된 슬롯 정렬로 대량 배치에 걸쳐 균일한 텍스처링 보장.
피라냐 용액 처리	황산 및 과산화수소를 사용한 유기 잔류물 및 포토레지스트의 강력한 제거.	극한의 발열 반응 및 고온 산성도를 견딤.
CMP 후 린싱	화학 기계적 연마 후 연마 슬러리를 제거하기 위한 웨이퍼의 중요한 세척.	매끄러운 표면과 높은 배수성으로 입자 재침착 방지.
화합물 반도체 준비	고급 전자 및 광전자 장치 제조를 위한 GaAs 또는 InP 웨이퍼의 전문 세척.	비표준 웨이퍼 두께 및 크기에 대한 맞춤형 슬롯 형상.
마이크로채널 반응기 적재	제어된 화학 기상 또는 액상 증착을 위한 맞춤형 반응 챔버 내 기관 위치 지정.	맞춤형 치수로 맞춤형 실험실 설정에 완벽하게 적합.
리소그래피 현상	미세 가공 워크플로우에서 포토레지스트 층의 현상 및 제거 중 기관 고정.	용제 저항성으로 공정 중 캐리어의 분해 또는 가스 발생 방지.

매개변수	PL-CP149에 대한 사양 상세
모델 식별자	PL-CP149 시리즈
재료 구성	100% 순수 고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
제조 방법	완전 맞춤형 CNC 가공
화학적 호환성	범용 (산, 염기, 용제, 산화제, HF)
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
웨이퍼 호환성	2", 3", 4", 6", 8", 12" 또는 비표준 크기에 맞춤 설정 가능
슬롯 구성	완전 맞춤형 (가변 피치, 너비 및 깊이)
슬롯 수	고객 요구 사항에 따라 정의 (예: 10, 25, 50 수용량)
헨들 설계	통합형, 분리형 또는 연장형 (맞춤형 길이)
표면 마감	매끄럽고 낮은 기공률의 가공 마감
순도 표준	미량 분석 및 Class 10/100 클린룸 사용에 적합

응용 분야	설명	주요 이점
매개변수	PL-CP149에 대한 사양 상세	
배수 기능	맞춤형 바닥/측면 배수 포트	